

процессов составляет 2—3 мкВт. Анализ выражения (5), а также выражений для спектров ООМСВ при $qd \ll 1$ для первых двух мод

$$\omega \approx \omega_0 - \omega_0 \frac{qd}{2} \left(1 - \frac{\omega_H^2}{\omega_0^2} \right), \quad \omega \approx \omega_0 - \frac{(qd)^3}{12} \frac{\omega_H \omega_H}{\omega_0} \quad (7)$$

показывает, что трехмагнитные распадные процессы запрещены ($V=0$), когда все волновые векторы направлены вдоль поля. Минимальный порог достигается при максимуме V . Анализируя зависимость выражения (5) от углов ϕ и ψ , можно показать, что максимум V , в частности, может быть достигнут в случае, когда одна из рожденных волн распространяется перпендикулярно полю, а другая под углом 45° к полю. Таким образом, в данной работе рассчитаны и оптимизированы пороги наступления трехмагнитных распадных процессов для ООМСВ.

Список литературы

- [1] Звездин А. К., Попков А. Ф. // ЖЭТФ. 1983. Т. 84. № 2. С. 606—615.
- [2] Калиникос Б. А., Ковшиков Н. Г., Славин А. Н. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 2. С. 159—176.
- [3] De Gasperis P., Marcelli R., Micolli J. // J. Appl. Phys. 1988. V. 63. № 8. P. 4136—4140.
- [4] Зильберман П. Е., Никитов С. А., Темирязев А. Г. // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 42. № 3. С. 92—94.
- [5] Гуляев Ю. В., Зильберман П. Е., Никитов С. А., Темирязев А. Г. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 6. С. 1794—1796.
- [6] Boardman A. D., Nikitov S. A. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 16. P. 11444—11451.
- [7] Дудко Г. М., Казаков Г. Т., Кожевников А. В., Филимонов Ю. А. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 12. С. 736—740.
- [8] Темирязев А. Г. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 2. С. 313—319.
- [9] Захаров В. Е., Львов В. С., Старобинец С. С. // ФТТ. 1969. Т. 11. № 10. С. 2922—2926.

Институт радиотехники и электроники
АН СССР
Фрязино
Московская область

Поступило в Редакцию
18 января 1990 г.
В окончательной редакции
16 апреля 1990 г.

УДК 538.945 : 539.166

© Физика твердого тела, том 32, № 10, 1990
Solid State Physics, vol. 32, N 10, 1990

ЦЕНТРЫ МЕДИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ И СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗАХ $YBa_2Cu_3O_{7-x}$

С. И. Бондаревский, В. Ф. Мастеров, П. П. Серегин

Проблема определения электронной структуры и параметров тензора градиента электрического поля (ГЭП) центров меди в полупроводниковой и сверхпроводящей модификациях $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ в настоящее время остается актуальной. Наиболее перспективными в этом отношении являются методы ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) [1, 2] и эффекта Мессбауэра на примесных атомах ^{57}Fe [3] и ^{119}Sn [4]. Однако указанные методы позволяют определить лишь значение постоянной квадрупольного взаимодействия e^2qQ для конкретных атомных центров в положении меди, но не позволяют извлечь информацию о величине eq_{kp} в узле меди (здесь eQ — квадрупольный момент исследуемого ядра; eq — главная компонента тензора ГЭП на исследуемом ядре; eq_{kp} — главная компонента тензора ГЭП, создаваемого ионами решетки в положении меди). Вследствие этого

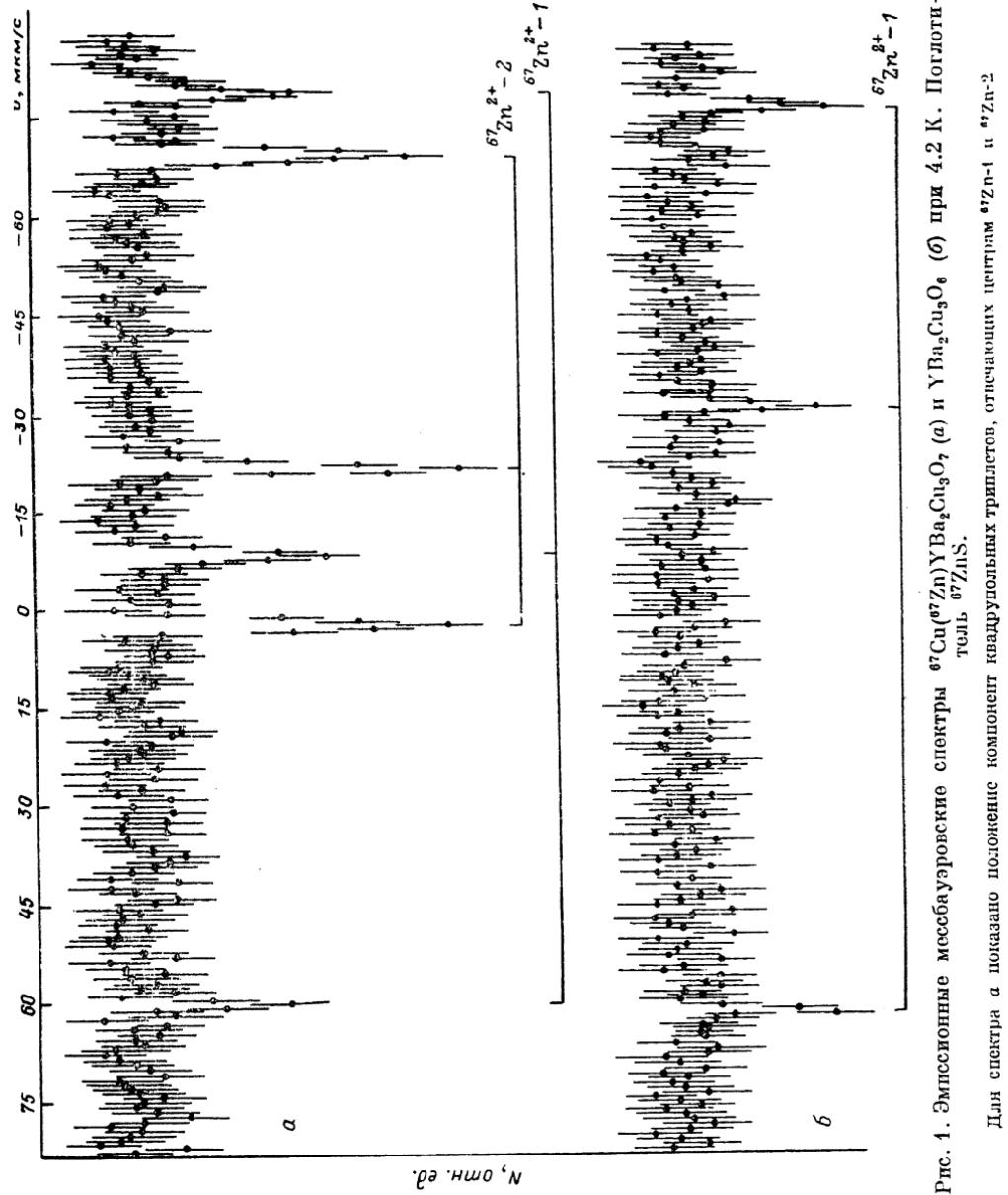


Рис. 4. Эмиссионные мессбауэровские спектры $^{67}\text{Cu}({}^{67}\text{Zn})\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (а) и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ (б) при 4.2 К. Поглотитель ${}^{67}\text{ZnS}$.
Для спектра а показано положение компонент квадрупольных триплетов, отнесенных центрам ${}^{67}\text{Zn}-1$ и ${}^{67}\text{Zn}-2$.

отсутствует возможность сравнения экспериментально измеренных параметров тензора ГЭП с результатами их теоретического расчета.

В настоящей работе для определения параметров тензора ГЭП центров меди в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ использован эмиссионный вариант спектроскопии на изотопе $^{67}\text{Cu}({}^{67}\text{Zn})$, а для идентификации электронной структуры центров меди — метод определения электронной плотности на ядрах меди $|\psi(0)|^2$ путем измерения постоянной радиоактивного распада ^{64}Cu .

Образцы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ имели орторомбическую структуру и $T_c \sim 85$ К, тогда как образцы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ имели тетрагональную структуру и оставались в полупроводниковом состоянии по крайней мере при $T \geq 4.2$ К.

Параметры тензора ГЭП для центров ^{67}Zn и ^{63}Cu в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$

Соединение	Центр	$e^2 q Q$, МГц	γ	q_{kp}
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	$^{67}\text{Zn-1}$	20.1 ± 0.5	0.95 ± 0.05	0.283
	$^{67}\text{Zn-2}$	11.8 ± 0.5	≤ 0.2	0.151
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$	$^{67}\text{Zn-1}$	-23.5 ± 0.5	≤ 0.2	0.299

Продолжение

Соединение	Центр	$e^2 q Q$, МГц	γ	P
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	$^{63}\text{Cu-1}$	38.3	0.98	0.52
	$^{63}\text{Cu-2}$	62.8	0.14	0.19
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$	$^{63}\text{Cu-1}$	60.1	0.0	0.39

Примечание. Данные для центров ^{63}Cu взяты из [1, 2]. Величины q_{kp} приведены в единицах $e/\text{\AA}^3$.

Как видно из рис. 1, а, мессбауэровский спектр $\text{YBa}_2^{67}\text{Cu}_3\text{O}_7$ представляет собой наложение шести линий, которые могут быть сгруппированы в два спектра: 1) менее интенсивные линии, 2) более интенсивные линии. Из рентгеноструктурных данных известно, что в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ атомы меди занимают два структурно-неэквивалентных положения Cu-1 и Cu-2, причем независимо от x заселенности этих положений относятся как 1 : 2 [5]. Исходя из этого, спектр 1 следует отнести к центрам ^{67}Zn в положениях Cu-1 (т. е. $^{67}\text{Zn-1}$), а спектр 2 — к центрам ^{67}Zn в положениях Cu-2 (т. е. $^{67}\text{Zn-2}$). Параметры тензора ГЭП для этих центров сведены в таблицу.

Для полупроводниковой модификации мессбауэровский спектр представляет собой квадрупольный триплет, отвечающий единственному состоянию центров ^{67}Zn (рис. 1, б). Отсутствие второго триплета объясняется антиферромагнитным упорядочением подрешетки Cu-2 для составов $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ с $x > 0.6$ [6]. Таким образом, спектр $\text{YBa}_2^{67}\text{Cu}_3\text{O}_6$ следует отнести к центрам ^{67}Zn в положении Cu-1 (т. е. $^{67}\text{Zn-1}$). Параметры тензора ГЭП для этих центров сведены в таблицу.

В общем случае ГЭП на ядрах атомов в кристаллах создается окружающими ионами q_{kp} и собственными несферическими валентными электронами атома q_{val} : $q = (1 - \gamma) q_{kp} + (1 - R) q_{val}$, где γ , R — коэффициент Штернхаймера. Исходя из химического состава исследованных керамик, атомы цинка, образующиеся после бета-распада ^{75}Cu , могут стабилизироваться только в состоянии Zn^{2+} (электронная конфигурация $3d^{10}$). Следовательно, для центров ^{67}Zn $q = (1 - \gamma) q_{kp}$, и это позволяет из экспериментальных значений $e^2 q Q$ рассчитать величину q_{kp} . Последние величины также приведены в таблице, и они могут быть сравнены с результатами теоретических расчетов q_{kp} , проведенных авторами [7]. Отметим, что общий результат теоретических расчетов для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ ($q_{kp1}/q_{kp2} = 1.6 - 2.0$) подтверждается полученными нами результатами (см. таблицу), од-

нако абсолютные экспериментальные значения q_{kp1} и q_{kp2} существенно отличаются от расчетных (здесь q_{kp1} , q_{kp2} — главные компоненты тензора ГЭП в положениях Cu-1 и Cu-2 соответственно). Переход от $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ сопровождается изменением e^2qQ и параметра асимметрии γ . Качественно это согласуется с результатами теоретических расчетов. В согласии с этими расчетами оказывается и отношение $(q_{kp1})_0/(q_{kp1})_t = 1.17$ (теоретическое отношение лежит в пределах от 1.10 до 1.26 [7]), но, как и в случае $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, отсутствует количественное согласие расчетных и экспериментальных значений q_{kp} (здесь $(q_{kp1})_0$, $(q_{kp1})_t$ — главные компоненты тензора ГЭП в положении Cu-1 для орторомбической и тетрагональной модификаций $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ соответственно). Очевидно, эти расхождения свидетельствуют о несовершенстве исходных предпосылок по теоретическому расчету ГЭП.

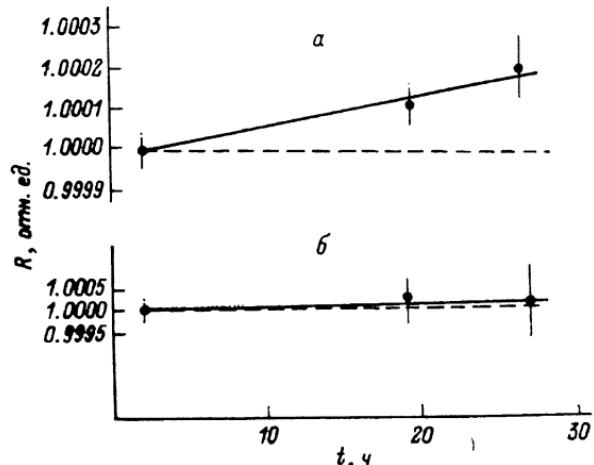


Рис. 2. Отношение скоростей счета в зависимости от времени для следующих пар источников излучения: $\text{YBa}_2^{64}\text{CuO}_7$ — $\text{YBa}_2^{64}\text{Cu}_3\text{O}_6$ (a), $\text{YBa}_2^{64}\text{Cu}_3\text{O}_7$ — $\text{YBa}_2^{64}\text{Cu}_3\text{O}_7$ (b).

Параметры тензора ГЭП для центров ${}^3\text{Cu}-1$ и ${}^3\text{Cu}-2$ в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ были определены методом ЯКР [1, 2]. Сопоставление величин e^2qQ , полученных двумя методами, позволяет оценить электронную структуру центров меди. С этой целью мы провели сравнение расчетного отношения $P = (e^2qQ)_{\text{Zn}^{2+}}/(e^2qQ)_{\text{Cu}^{+}} = 0.59$ с экспериментальными отношениями P для положений Cu-1 и Cu-2 (см. таблицу). Значительное расхождение расчетных и экспериментальных значений P для положения Cu-2 свидетельствует о заметном вкладе в ГЭП на ядрах ${}^3\text{Cu}$ от незаполненной 3d-оболочки меди, т. е. центры Cu-2 стабилизируются в виде Cu^{2+} ($3d^9$). Для положения Cu-1 для обеих керамик расчетные и экспериментальные значения P близки (хотя и не совпадают). Это, очевидно, означает справедливость предположения о стабилизации меди в положении Cu-1 в виде Cu^{+} (электронная конфигурация близка к $3d^{10}$). Однако однозначного вывода о возрастании или уменьшении заселенности 3d-оболочки меди в состоянии Cu-1 при изменении x сделать нельзя. Для решения этой проблемы мы измерили отношение скоростей процесса электронного захвата в ${}^{64}\text{Cu}$ для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$.

Из рис. 2 видно, что переход от $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ сопровождается уменьшением скорости электронного захвата. Поскольку вероятность процесса электронного захвата на ядрах ${}^{64}\text{Cu}$ пропорциональна $|\psi(0)|^2$, где $\psi(0)^2$ — электронная плотность на ядрах ${}^{64}\text{Cu}$, то, следовательно, при переходе от сверхпроводящей к полупроводниковой модификации $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ электронная плотность на ядрах ${}^{64}\text{Cu}$ уменьшается. Иными словами, заселенность 3d-оболочки центров Cu-1 в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ оказывается меньше, чем в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$. Конечно, это рассмотрение является справедливым, если заселенность 3d-оболочки центров Cu-2 при указанном переходе существенно не изменяется.

Список литературы

- [1] Brinkmann D. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 737—738.
- [2] Lippmaa E., Joon E., Heinmaa I., Miidel V., Miller A., Stern R., Furo I., Mihaly L., Banki P. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 91—94.
- [3] Bottyan L., Molnar B., Nagy D. L., Szucz I. S., Toth J., Dengler J., Ritter G., Schober J. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 16. P. 11373—11381.
- [4] Zhang H., Wang G. M., Zhang Q. R. // Phys. Lett. 1989. V. 138. N 9. P. 517—522.
- [5] Yvon K., Francois M. // Z. Phys. B. 1989. V. 76. N 4. P. 413—444.
- [6] Burlet P., Vettier C., Jurgens M., Henry J. Y., Rossat-Mignod J., Noel H., Potel M., Gougeon P., Levet J. C. // Physica C. 1988. V. 153—155. P. 1115—1120.
- [7] Lyubutin I. S., Terziev V. G., Dmitrieva T. V., Gor'kov V. P. // Phys. Lett. A. 1989. V. 137. N 3. P. 144—148.

Ленинградский государственный университет

Поступило в Редакцию
17 апреля 1990 г.

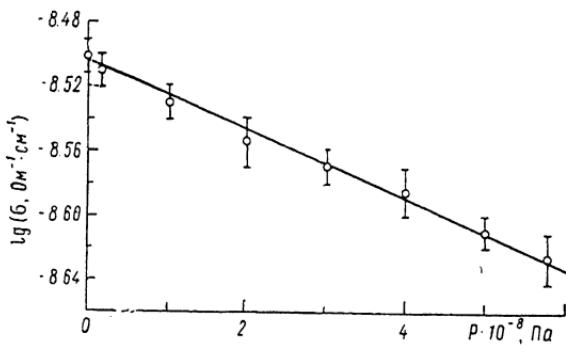
УДК 541.135.4

© Физика твердого тела, том 32, № 10, 1990
Solid State Physics, vol. 32, N 10, 1990

ПРОВОДИМОСТЬ СУПЕРИОННОГО КРИСТАЛЛА SrF_2 С 20 мол.% LaF_3 ПРИ ВЫСОКОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ

Н. И. Сорокин

Ранее нами было проведено систематическое экспериментальное исследование фтор-ионного переноса в монокристаллах нестехиометрических фторидных фаз со структурой флюорита [1—3]. Использование гидростатического давления в измерениях проводимости ионных кристаллов позволяет находить активационные объемы различных процессов, определяющих ионный транспорт (например, активационные объемы образования и миграции дефектов, ассоциации примесей). До сих пор электропроводность щелочноземельных фторидов при гидростатическом давлении изучалась лишь в стехиометрических и слаболе-



Зависимость ионной проводимости от давления для монокристаллического твердого раствора $\text{Sr}_{0.8}\text{La}_{0.2}\text{F}_{2.2}$ при 294 К.

гированных (доли мол.% примесей) кристаллах [4, 5]. В настоящей работе приводятся результаты по исследованию влияния высокого гидростатического давления на ионный перенос в сильно нестехиометрическом (десятки мол.% примесей) фториде.

В качестве объекта исследований был выбран ранее нами использованный в измерениях температурной зависимости электропроводности [1, 6] монокристалл концентрированного твердого раствора SrF_2 с 20 мол.% LaF_3 , обладающий высокой величиной фтор-ионной проводимости, которая определяется миграцией «примесных» ионов фтора, образующихся в твердом растворе в результате изоморфных гетеровалентных катионных замещений ($\sigma \approx 1 \cdot 10^{-4} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ при $T=500$ К). Подробное описание экспериментальной установки приведено в [7]. Диапазон гидростатических давлений P составлял 10^5 — $6 \cdot 10^8$ Па. В качестве среды, передающей давление, использовали силиконовое масло. Величину ионной проводи-